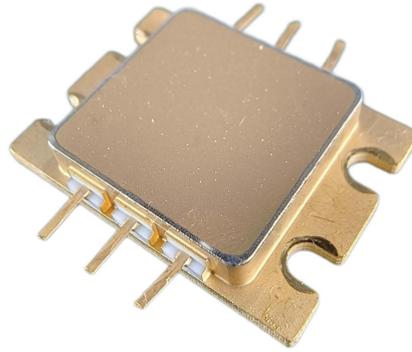


0.9-1.2 GHz GaN Internally-matched Power Transistor

产品特性：

工作频率 0.90~ 1.20GHZ

饱和输出功率 $P_{sat} = 53.5\text{dBm}$ (Type)功率增益 $\text{Gain} \geq 13\text{dB}$ 工作效率 $\eta = 50\%$ (Type)端口匹配 $Z_{in}/Z_{out}=50\Omega$ **产品说明：**

HXN40004是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺，产品的典型工作频带为0.9~1.2GHZ，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

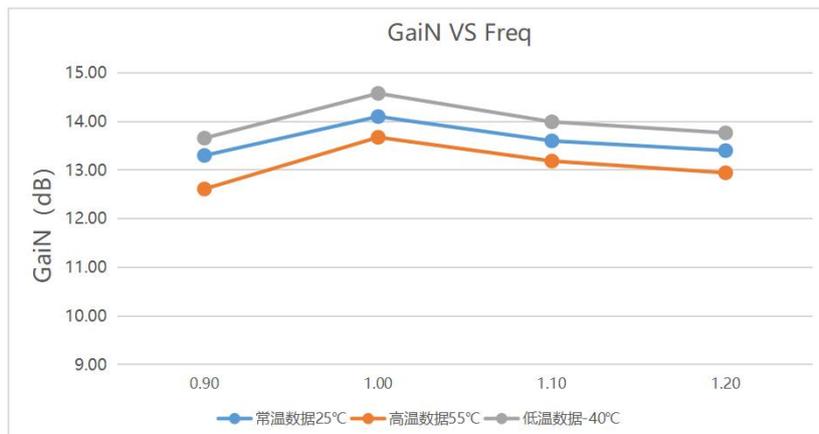
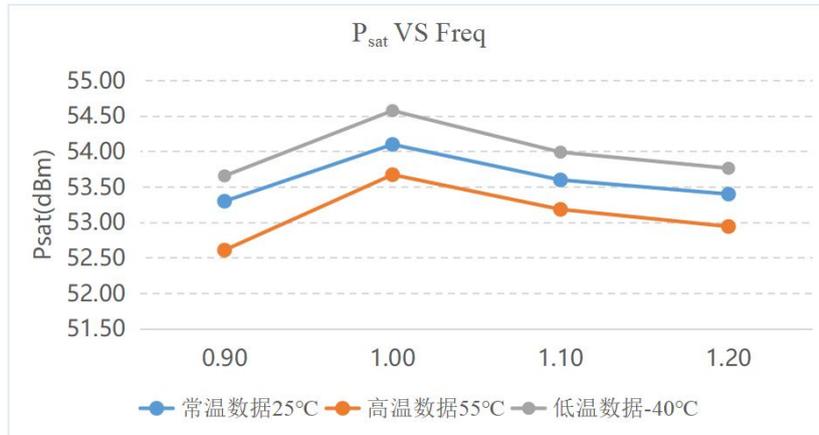
最大额定值 (TC=25°C, 不推荐在此条件下工作)：

	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	40	V
栅源电压	V_{GS}	-5	V
存储温度	T_{stg}	-65 to +150	°C
沟道温度	T_{ch}	150	°C

微波电性能：

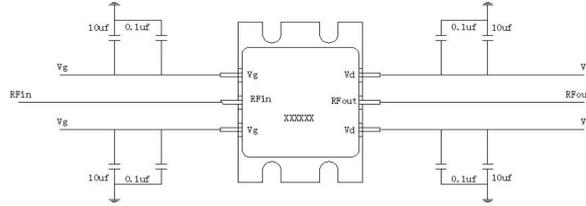
	符号	测试条件	值			单位
			Min	Typ	Max	
漏极电流	I_{dsr}	$V_{DS}:32V$	-	12.5	-	A
饱和输出功率	P_{sat}	脉冲工作	-	53.5	-	dBm
功率增益：	G_p	$T=1\text{ms}, \text{Duty}=10\%$	13	-	-	dB
工作效率：	η	$\text{Pin}: 40\text{dBm}$	-	50	-	%
增益平坦度	ΔG	$\text{Freq}: 0.9\sim 1.2\text{GHZ}$	-0.8	-	0.8	dB

典型曲线



0.9-1.2 GHz GaN Internally-matched Power Transistor

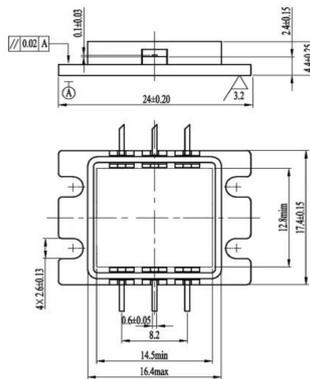
推荐应用电路：



防静电等级：

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

外观尺寸：



使用注意事项：

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。